

高周波、低消費電力 MEMSリレー

当社の高周波MEMSリレーは、圧電駆動方式を採用しており、低消費電力、高信頼性を兼ね備えています。当社独自の成膜技術により、薄さ1 μm の圧電膜を実現したことで、低電圧駆動が可能になりました。半導体試験装置で実績を重ねてきた接点制御技術により、動作は信頼性が高く、高周波計測技術により、最大20GHzの高周波伝送に対応します。

MEMSリレーの用途



半導体検査装置、高速通信機器、高周波計測器など

MEMSリレー製造工程



当社の持つMEMS開発/製造力

開発拠点: アドバンテスト群馬R&Dセンター(群馬県邑楽郡明和町)
アドバンテスト研究所(仙台市青葉区)
東北大学工研教授の指導の下で実用化。

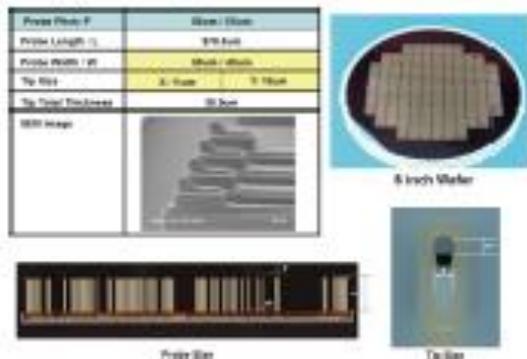
製造拠点: アドバンテスト コンポーネント(仙台市青葉区)
自社工場でMEMS関連製品や化合物半導体、高周波モジュール向けSP等を量産。

MEMSリレーの主な仕様値(参考値)

周波数範囲: DC~20GHz
 駆動電圧: 12V
 接点構成: SPDT
 サイズ(mm): 5.4x4.2x0.9 2.9x3.4x0.9 の2種類
 インシレーション: >20dB(−20GHz)
 挿入損失: <1dB(−20GHz)
 特性インピーダンス: 50 Ω

MEMSプローブピン

半導体ウエハ試験に使用されるプローブカード用の針をMEMS技術を用いて作成しています。



アドバンテストについて

「計測と試験」における世界のリーディングカンパニーとして、エレクトロニクス、情報通信、半導体製造といった、最先端の計測技術を必要とする産業で活躍しています。半導体・部品テスト・システム事業では、各種半導体デバイスの信頼性を支えるテスト・システムを提供し、世界で50%近くのシェアを持っています。

